様式第十三（第９条第１項関係）

特定半導体生産施設整備等計画の認定申請書

年　　月　　日

経済産業大臣　名　　殿

住　　所
名　　称
代表者の氏名

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第１１条第１項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたいので申請します。

特定半導体生産施設整備等計画

１　名称等（注１）

（１）代表申請者の名称等

事業者の氏名又は名称　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名（事業者が法人の場合）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資本金の額又は出資の総額　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

常時使用する従業員の数　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日本標準産業分類における該当中分類名称及びその番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者連絡先（所属、氏名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２）共同申請者の名称等

事業者の氏名又は名称　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名（事業者が法人の場合）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資本金の額又は出資の総額　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

常時使用する従業員の数　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日本標準産業分類における該当中分類名称及びその番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者連絡先（所属、氏名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注１）　代表申請者に特定半導体の生産実績がない場合は、生産実績を有する事業者との共同申請を必ず行うこと。その際、代表申請者との資本関係を示す資料及び代表申請者が本計画に基づいて行う事業が実施できなくなった場合に当該事業を引き継いで実施する又は特定半導体の生産を代わりに行うことができる旨の誓約書、添付書類を提出すること。

また、代表申請者又は代表申請者に特定半導体の生産実績がない場合に共同申請する生産実績を有する事業者は、国内法人（国内に本店又は主たる事務所を有する法人）であること。

2　特定半導体生産施設整備等計画の目標

3　特定半導体生産施設整備等計画の内容及び実施期間

（1）特定半導体生産施設整備の内容

（イ）施設概要

施設の名称				
施設の所在地（住所）（注２）				
敷地面積		㎡	建築面積	㎡
主要製品				
生産能力（想定する稼働率）	（　　）		万枚／月（１２インチ換算）（%）	
総従業員数（注３）（うち技術者数）	（　　）		人	

（注２）土地・建物の所有関係に関する資料、工場等の配置図、設計図、設備の配置図を提出すること。
（注３）生産開始時に予定する従業員の人数を記載すること。

（ロ）事業実施期間

	投資着手（発注）	建物新設、設備設置	操業開始
特定半導体生産施設整備	年　月	年　月～　年　月 （最短で▲ヶ月間必要）	年　月

（２）特定半導体生産施設における生産の内容

（イ）施設で生産を行う半導体に関する内容

種類（注４）	性能に関する説明（注５）（注６）

（注４）演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（積層された一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の層の数が百六十以上）のいずれかから選択し記載すること。

（注５）生産予定の製品が政令で定める要件を満たす旨を記載すること。また、生産予定の製品が記載する性能を満たすことを示す書類を認定計画申請時及び初回の製品生産時に提出すること。

（注６）生産予定の製品が「演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）」の場合は、ゲート絶縁膜に比誘電率が７を超える材料を用いるための装置を使用して生産することを示す書類及び当該生産に係る特定半導体生産施設整備等計画を申請する事業者のうち１以上の事業者がＦｉｎＦＥＴ構造の演算を行う半導体を生産できると認められる技術水準を有することを示す書類を提出すること。
生産予定の製品が「記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）」の場合は、当該生産に係る特定半導体生産施設整備等計画を申請する事業者のうち１以上の事業者が極端紫外線を用いて露光できると認められる技術水準を有することを示す書類を提出すること。

（ロ）特定半導体生産施設整備等計画の下での事業実施期間

	初回出荷	継続生産
特定半導体生産施設における生産	年　月	年　月～　年　月

（ハ）製品の納入先に関する説明

（ニ）コア技術等に関する説明（注７）

（注７）本計画の認定の対象とする取組における生産に有用かつ中核的な技術（公然と知られていないものに限る）を「コア技術」と定義し、コア技術及びコア技術の実現に直接寄与する公然と知られていない技術を「コア技術等」と定義する。

（３）指針適合性の確保

項目		確保措置の内容（注８）
整備適合性	必要な設備の整備	□　特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針（以下「指針」という。）第四　一　２に掲げる設備の整備を含んでいる。
	指針に適合する設備の整備	□　整備する設備は指針第四　一　３に掲げるいずれかに含まれる。
	指針に適合する施設の整備	□　整備する施設は指針第四　一　４に掲げるいずれかに含まれる。
安全性・信頼性	所有関係及びガバナンスの透明性の確保	
	過去三年間の実績を含めた、国際的に受け入れられた基準の遵守（注９）	□　過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していない。
	外国の法的環境等による特定半導体生産施設整備等の適切性への影響	
	生産を行う特定半導体のサイバーセキュリティの確保に関する対策及び生産施設におけるサイバーセキュリティの確保に関する対策	
	コア技術等の流出防止に関する取組	□　指針第四　一　１３に掲げる措置を実施する。
供給安定性等	サプライチェーンを含む必要な生産能力確保に関する計画の整備	□　必要な計画を整備している。
	事業継続計画の策定	
	特定半導体の生産に係る国内関係法令の遵守	
	人材確保に関する取組	
	その他国内の特定半導体の安定供給に資する取組	

（注８）必要に応じて各項目を証明する書類を提出すること。
（注９）過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していない場合は、□にレ印を付けること。

4　特定半導体生産施設整備等の実施体制

（１）特定半導体生産施設整備の実施体制

（２）特定半導体生産施設における生産の実施体制

（注１０）主な部署とその人数を記載すること。

5　特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の額及びその調達方法

（イ）特定半導体生産施設整備を行うために必要な資金の額及びその調達方法

（単位：百万円）

費用＼調達方法		政府関係金融機関からの借入れ	民間金融機関等からの借入れ	その他自己資金等（注１３）	合計	備考
特定半導体生産施設整備に必要な資金の合計額		調達先の名称： 借入額：	調達先の名称： 借入額：			
特定半導体生産施設整備に必要な資金の額	年度					
	年度					
	年度					
	年度					
	年度					

（注１１）「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他自己資金等」には自己資金、出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」及び「民間金融機関等からの借入れ」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び金額の内訳を示しつつ記載する。

（注１２）民間金融機関からの融資について信用保証協会による保証を受ける期待がある場合には、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。

（注１３）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）からの助成金を含む。

（ロ）整備した特定半導体生産施設における生産を行うために必要な資金の額及びその調達方法

（単位：百万円）

費用＼調達方法		政府関係金融機関からの借入れ	民間金融機関等からの借入れ	その他自己資金等	合計（注１７）	備考
特定半導体生産施設における生産に必要な資金（注１４）の合計額		調達先の名称： 借入額：	調達先の名称： 借入額：			
特定半導体生産施設における生産に必要な資金の額	年度					
	年度					
	年度					
	年度					
	年度					

（注１４）「整備した特定半導体生産施設における生産を行うために必要な資金」は、生産を開始する前に必要な資金を含め、特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金のうち５（イ）特定半導体生産施設整備を行うために必要な資金を除いたものをいう。

（注１５）「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他自己資金等」には自己資金、出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」及び「民間金融機関等からの借入れ」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び金額の内訳を示しつつ記載する。

（注１６）民間金融機関からの融資について信用保証協会による保証を受ける期待がある場合には、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。

（注１７）「特定半導体生産施設における生産に必要な資金の合計額」の「合計」欄以外の記載欄については、整備した特定半導体生産施設における生産に係る支援措置の利用を希望する場合には記載。

6　希望する支援措置等

（1）希望する支援措置

支援措置	希望する	希望しない
株式会社日本政策金融公庫法の特例（ツーステップローン）（注１８）		
中小企業投資育成株式会社法の特例		
中小企業信用保険法の特例		
株式会社日本政策金融公庫（中小事業）の貸付（低利融資）		
ＮＥＤＯによる助成金の交付（注１９）		
ＮＥＤＯによる認定事業者に貸付けを行う金融機関に対する利子補給の支給（注１８）		

（注１８）ツーステップローン、利子補給を受けた融資の使途は５（ロ）整備した特定半導体生産施設における生産関係に限る。
（注１９）助成金の使途は５（イ）特定半導体生産施設整備関係に限る。

（2）特定半導体生産施設整備に係る支援措置の利用を希望する施設・設備（希望する場合のみ記載）

（単位：百万円）

	設備投資所要資金額	導入する設備等の種類（注２０）	導入する設備等の用途	数量	単価	金額	設置場所
年度							
年度							
年度							
合計額							

（注２０）導入予定の設備リスト及び金額の算出根拠を提出すること。
（注２１）ＮＥＤＯによる特定半導体基金の助成金の交付決定前に事業に着手（発注、調達、購入等）を行う必要がある場合には、事前着手説明書を提出すること。

7　特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組に関する事項

（1）本事業による日本の特定半導体の安定供給体制の構築への貢献に関する説明

（2）需給がひっ迫した場合における増産に関する記載

（イ）増産協力に係る協議依頼があった場合の協議への対応意思の有無　　有□　　無□

（ロ）需給がひっ迫した場合における増産に関する取組内容・体制の説明

（３）特定半導体等の生産能力を強化するための投資に関する説明

（４）特定半導体等の生産能力を強化するための研究開発に関する説明

（５）特定半導体等に係る技術上の情報を適切に管理するための体制に関する説明（注２２）

（注２２）情報管理体制確認票を提出すること。

添付書類目次

添付書類

１－（１）	定款（これに準ずるものを含む。）の写し
１－（２）	登記事項証明書（生産施設整備等計画申請者が登記をしている場合）
２－（１）	事業報告の写し又はこれに準ずるもの
２－（２）	貸借対照表又はこれに準ずるもの
２－（３）	損益計算書又はこれに準ずるもの
３	計画の実施に必要な資金の使途及びその調達方法の内訳

（備考）

１．経済産業大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。